高速光伝送用ガラスインターポーザ

光電子技術研究所 松丸 幸 $\mathbb{P}^1 \cdot \mathbb{P}$ 里弘 $\mathbb{A}^1 \cdot \mathbb{U}$ 本 $\mathbb{A}^2 \cdot \mathbb{L}$ 道 雄 \mathbb{A}^3

Glass Interposer for High Speed Optical Transmission

K. Matsumaru, H. Nakazato, S. Yamamoto, and Y. Uemichi

情報通信機器のさらなる高速化に対応するため,光デバイスとプリント回路基板の間をつなぐ高速光 伝送用ガラスインターポーザを開発した.ガラスは絶縁体であるため,伝送線路から基板へ信号が漏洩 する懸念がなく,高速伝送が期待できる.また,ガラスは透過率に優れることから,光デバイスのパッ ケージで使用するインターポーザとして有望である.本論文では,ガラスインターポーザの作製方法, および作製したガラスインターポーザの構造的評価や電気的特性について報告する.

A glass interposer which connects optical devices and a printed circuit board for high speed optical transmission has been developed. As glass material is an excellent insulator and prevents current leakage from circuits into a substrate, higher speed transmission is expected than a conventional interposer. The glass material also shows so good transparency that it is suitable for use in optoelectronics device packaging. This paper reports the fabrication method and the structural and electrical properties of the novel glass interposer.

1. まえがき

近年,情報ニーズの多様化とデジタル化にともない, 情報通信機器はさらなる高速化が求められている. 従来 使用されてきたメタル配線では高速化に限界があるた め、伝送速度、伝送距離、消費電力に優れた光インター コネクションが注目されている¹⁾. 光インターコネクシ ョンを用いたデータ伝送システムは、信号送信IC(トラ ンスミッタ),プリント回路基板やケーブルなどの電気 接続媒体(チャネル),信号受信IC(レシーバ)で構成 される. ICとプリント回路基板では配線のデザインルー ルが異なるため、インターポーザが必要となる、これま で当社では、インターポーザなどへの応用を目的に、ガ ラスに微細な貫通配線を形成する技術の開発を行ってき た²⁾. ガラスは透過率に優れることから, 光インターコ ネクションで使用するインターポーザの基板材料として 有望である、そこでわれわれは、基板材料にガラスを用 い、貫通配線を適用した光デバイスとプリント回路基板 の間をつなぐ高速伝送用インターポーザを開発した.本 論文では、ガラスインターポーザの構造や作製方法、お よび電気的特性の評価結果を報告する.

2. ガラスインターポーザの構造

開発したガラスインターポーザの断面模式図を図 1 に示す.本開発では、光デバイスとプリント回路基板を 電気的に接続するためのインターポーザを目指している ため、使用するガラス基板の種類や伝送線路の構造に、 いくつかの設計上、構造上の工夫をほどこしている.以 下、これらの点について詳しく説明する.

2.1 ガラス基板の種類

図 1 に示すように、光デバイスとインターポーザの 接続は、一般的にフリップチップ実装が用いられる.フ リップチップ実装は、ワイヤボンディングによる接続に 比べて配線長が短く、寄生パラメータ(LCR)が小さい





¹ シリコン技術研究部

² シリコン技術研究部グループ長(工学博士)

³ 応用電磁気研究室

略語・専門用語リスト 略語・専門用語	正式表記	説 明
インターポーザ	Interposer	端子間距離が異なる基板同士を中継する基板
光インターコネクション	Optical interconnection	都市間の長距離光通信にくらべ、ごく短い距離のデータ伝 送に光通信を用いること
フリップチップ実装	Flip chip bonding	基板にICチップを直接実装するベアチップ実装の一つで、 ICチップの電極と基板の電極を対向させフェースダウンし て一括接続させる実装方法
サンドブラスト	Sandblasting	圧縮空気を用いて研磨剤を表面に衝突させる加工法

ので、高周波での伝送特性に優れるためである.フリッ プチップ実装では、光デバイスの受発光面が基板と対向 するように配置される、いわゆるフェースダウンとなる ため、光信号はインターポーザの厚さ方向に通過する. そのため、光信号の光路の位置精度は、インターポーザ の実装パッドの平面方向の位置精度に大きく依存する. また、フリップチップ実装は高温下で行われるため、光 デバイスとインターポーザの熱膨張係数差が小さいほど 残留応力の小さい実装が可能になる.本開発では、精度 の高い加工が可能な半導体プロセスを適用でき、かつ光 デバイスの基板材料のシリコンや化合物半導体との熱膨 張係数差が小さいホウ珪酸ガラスをインターポーザの基 板材料とした.

2.2 貫通配線構造の適用

発光素子である面発光レーザは、熱抵抗が大きく、通 電による発熱が素子特性に与える影響が大きいため、放 熱機構が重要である.従来の片面だけのインターポー ザ、つまり光デバイスの実装面とプリント回路基板との 実装面が同一面にある場合は、発光素子近傍に放熱機構 を設けることが難しく効果的な放熱が困難であり、モジ ュール全体の特性が大きく損なわれる可能性がある.そ こで本インターポーザでは、基板の表裏を電気的に結ぶ 微細な配線である貫通配線構造を適用した.これにより 図 1 に示すように,発光素子のみをインターポーザの 片面に配置できるため,放熱面積を大きく取れるように なる.また,放熱機構を設ける際にも容易に設置できる ようになるため,効果的な放熱が可能となりモジュール の安定性・信頼性を高めることができる.

2.3 伝送線路

図2に、一般的な受光素子と発光素子、およびそれ らの制御用ICの外部回路を示した模式図を示す.発光 素子と制御ICの間、および制御ICからプリント回路基 板の間の伝送線路に高速信号が流れる.発光素子と制御 ICの間は、コプレーナ伝送線路で接続し、特性インピ ーダンスが 50 Ωとなるように配線設計した. 制御IC から貫通配線をかいしてプリント回路基板までつながる 伝送線路は,特性インピーダンス 100 Ωの差動伝送線 路とした. 設計した伝送線路, 特に本インターポーザの 特長である貫通配線を含む差動線路について、最適な設 計指針を得るため電磁界解析を行った. 電磁界解析には ANSYS社の3次元電磁界解析ソフトHFSSを用いた. 電磁界解析のモデルを図 3 に示す. ここでは貫通配線 の間隔は 350 µmとし, 形状を図 3 (a), (b) に示す 2 種類とした.図 3(a)のモデルは、実際に作製した貫通 配線の形状に近くテーパ形状であり, スルーホール内部 は導体で完全に満たされていない.図3(b)のモデル は、円柱状の貫通配線であり、スルーホール内部が完全



図2 ガラスインターポーザを用いた光モジュールの 模式図 Fig. 2 Schematic diagram of an optical module with





図3 伝送線路の解析モデル Fig. 3. Analyzed model of transmission lines.

に導体で埋まっている. 図 4 に,透過特性と反射特性の解析結果を示す.透過特性,反射特性共に(a)のモデルの方が,(b)のモデルに比べて伝送特性が優れている. これは,(a)の貫通配線はテーパ形状であるため,ガラス基板の内部においては隣り合う貫通配線との間隔が拡がっている. したがって,隣り合う貫通配線間の結合容量Cが小さくなるため,結果として伝送特性が良くなったと考えられる.(a)のモデルにおいては透過損,反射損共に小さく,26 GHzまで問題なく伝送できることを確認した.

3. ガラスインターポーザの作製

図5に、ガラスインターポーザの作製プロセスを示 す.はじめに、貫通配線を形成するためのスルーホール をガラス基板に形成する.本開発では、スルーホールの 形成方法として、ウエハでの加工が可能でテーパ形状の スルーホールを容易に作製できるサンドブラストを用い た.つぎに、デバイスやプリント回路基板が接続される 個所に応力緩和樹脂層を形成する.応力緩和樹脂は、デ バイスやプリント回路基板との接続に利用されるはんだ が凝固収縮する際、その応力によりガラスが割れること を防ぐためのものである.樹脂材料として、耐熱性や機 械的強度、耐薬品性に優れた感光性ポリイミドを用い た.つぎに、電解めっきにより、スルーホール内部とガ





ラス基板表面に銅膜を形成する.本開発では、スルーホ ールの内壁に一様にめっき膜を形成する、いわゆるコン フォーマルめっきを用いた.その後、回路の表面の保護 やはんだ実装時に余計な場所へのはんだの濡れ拡がりを 防止するパッシベーション層を形成する.パッシベーシ ョン層の材料もポリイミド樹脂を用いた.さらに、はん だを実装するパッド上に、はんだの濡れの向上と最表面 の保護を目的とした金層を無電解めっきにより形成す る.最後にダイシングを実施し、ウエハからチップへと 切り分け、ガラスインターポーザが完成する.

4. 特性評価

4.1 構造評価

作製したガラスインターポーザの外観写真を図 6 に 示す. インターポーザの大きさは 7 mm×9 mm, 厚さ は 500 μmであり, 貫通配線がペリフェラル状に配置 されている. 一方の面には光デバイスと制御ICが実装 され, 他方の面にはプリント回路基板が接続され, 両者 が貫通配線を介して電気的に接続された光モジュールの

1. スルーホール形成





図5 ガラスインターポーザの作製プロセス Fig. 5. Schematic process-flow of glass interposer.



図6 ガラスインターポーザの外観 Fig. 6. Top view of glass interposer.



図7 貫通配線の断面 Fig. 7. Cross-sectional view of through-hole interconnections in glass substrate.

実証に成功した. 貫通配線部の断面顕微鏡写真を図 7 に示す. スルーホールの開口径は 200 µm, 深さは 500 µm, テーパ角はおよそ 75°であり, コンフォーマ ルめっきによりスルーホール内部にめっき膜が形成でき ていることが確認できる. スルーホール内の銅の厚さは 最も薄い箇所でおよそ 3 µmであった.

4.2 貫通配線の抵抗値測定

貫通配線の抵抗値を,モデルによる計算と実際の測定



図8 抵抗値計算のモデル Fig. 8. Calculation model of resistance.

により比較検討した. 図 8 にスルーホールの抵抗値計 算のモデルを示す. ここでは形状として円錐の内側が中 空になっている構造をモデルとして設定し, スルーホー ルの内壁に均一に 3 μmの銅があった場合について計 算を行った. その結果,抵抗値は 7.4 mΩと見積もら れた. 一方,実際に作製したガラスインターポーザの抵 抗値を測定した結果,貫通配線 1 本当たりの抵抗値は 約 6 mΩであり,計算値と良い一致を示した. また, 26 Gbpsの信号が問題なく伝送できることを確認してい ることから,作製したインターポーザは,光インターコ ネクション等の高速伝送用インターポーザとして十分利 用できることを確認した.

5. む す び

情報通信機器のさらなる高速化に対応するため,光デ バイスとプリント回路基板の間をつなぐ高速伝送用ガラ スインターポーザを開発した.作製したガラスインター ポーザは,光インターコネクションへの応用に十分な電 気的特性を有していることを確認した.今後は信頼性の 評価を行う予定である.特に,ガラスは脆性材料である ことから,耐衝撃性や経時的な特性の変化に対して調査 を行っていく.

参考文献

- 平ほか:「サーバの低消費電力光インターコネクション」、エレクトロニクス実装学会誌, vol.12, No.5, pp.429-433, 2009.
- 2) 山本ほか:「トゥルー3次元配線」,フジクラ技報,第 118号, pp.39-45, 2010